طراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO

حامد صفارزاده'، على اسماعيلي'، محمد حسن جوارشكيان"

^۱دانشجوی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان Hamed.Saffarzadeh@gmail.com ۲دانشجوی ارشد هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد Aliesmaeli30316@yahoo.com <u>۲</u>دانشیار و عضو هیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد <u>Javareshkian@um.ac.ir</u>

چکیدہ

در این مطالعه به طراحی و بهینه سازی دمپر سیلندر پیستون با سیال هوشمند مگنتولوژیک پرداخته می شود. دمپر مورد نظر باید دارای ابعاد هندسی و انرژی الکتریکی مصرفی حداقل اما با بیشـترین نیروی میرایی و سرعت عکسالعمل بالا باشد، این امـر مسـتلزم یـک طراحی و بهینه سازی دقیق میاشد ابتدا پارامترهای موثر بر عملکرد این دمپرها شناسایی شده و میزان اثرگذاری هر کدام از آنها بر عملکرد سیستم مورد مطالعه قرار می گیرد سپس توسط سیستم معكوس طراحي ، دمپر بهينه بدست خواهد آمد. اين سيستم معکوس ترکیبی از مدل نیوروفازی و الگوریتم ازدحام ذرات می باشد. برای این منظور ابتدا یک دمپر سیلندر پیستون با سیال مگنتولوژیک شبیه سازی شده و عملکرد آن به وسیله مدل نیوروفازی پیش بینی و سپس با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه سازی می گردد. در این مدل سازی مقدار ضخامت مجرا، طول قطب پیستون، تعداد دور سیم پیچ و تعداد قرقرههای سیم پیچی که از پارامترهای مهم دمپر ام-آر بشمار میروند به عنوان ورودی و نسبت نیرو به زمان واکنش و انرژی الکتریکی مصرفی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود. تا بتوان یک دمپر ایدهال با بیشترین نیروی میرایی و صرف کمترین میزان انرژی الکتریکی و سرعت واکنش بالا طراحی نمود

واژه های کلیدی

دمپـر هوشــمند- ســيال مگنتولوژيـک- الگــوريتم PSO- روش نيروفازى

مقدمه

ایزولاتور یا سیستمهای تعلیق میتوانند برای کنترل ارتعاشات سیستمهای در حال حرکت مورد استفاده قرار گیرند برای کاهش ارتعاشات، تاثیر کنترل ارتعاشات بر روی ایزولاتورها یا سیستمهای تعلیق ضروری میباشد. برخی از این ایزولاتورها به گونهای هستند که هیچ بازخوردی در فعالیت آنها وجود ندارد و برای یک حالت بحرانی طراحی می شوند که این نوع از دمپرها چندان مطلوب نمیباشند. دسته دیگر به گونهای هستند که ارتعاشات وارده را حس کرده و بسته به دامنه ارتعاشات واکنش نشان میدهند. مزیت سیستم فعال این است که می تواند خود را با ارتعاشات سیستم تطبیق دهد. دسته دیگر که به آنها سیستم کنترلی نیمه فعال می

گویند، همانند سیستمهای فعال قابلیت تطابق پذیری ارتعاشات بر حسب میزان انرژی پراکندگی بر مستهلک کننده را دارند و بر حسب نیاز خصوصیات عملکردی مختلفی پیدا میکنند، اما مزیت اصلی سیستم کنترل نیمه فعال بر سیستم فعال صرف انرژی خیلی کمتر و زمان واکنش پایین تر میباشد. به همین دلیل است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و لزوم طراحی چنین دمپرهایی شدیدا احساس می شود. در سیستم نیمه فعال از سیالات هوشمند برای کاهش ارتعاشات استفاده می شود. یکی از سیالاتی که در چند سال اخیر توجه ویژهای به آن شده سیال مگنتولوژیک است. این سیال به گونهای است که هنگام قرار گیری در میدان مغناطیسی، ويسكوزيته آن تغيير مىكند. با توجه به قابليت اين سيال و نيز سیستم کنترلی نیمه فعال، میتوان از این سیال در ساخت دمپرها استفاده نمود. دمپرهای سیلندر پیستون مگنتولوژیک دمپرهایی هستند که یک پیستون الکترومغناطیسی از آن عبور کرده و بر سیال ام.آر(M.R) فشار وارد می کند. در اثر عبور سیال از میدان مغناطیسی تنش تسلیم تغییر کرده و این تغییرات خواص منجر به افزایش نیروی میرایی بیش از ده برابر می شود. اخیراً ارتعاشات نیمه فعال با سیال ای.آر(E.R) مورد تحقیقات وسیعی قرار گرفته است. الگوریتم کنترلی مود لغزشی توسط ونگ و همکارانش [۱] ارایه شده است. برای تاثیر بیشتر میزان دمپ سیال ای.آر بر یک سازه کنترل ارتعاشاتی نتایج تجربی دمپرهای ای.آر برای محافظت از ارتعاشات حاصل در تحقیق دایک ^۲بررسی شده است[۲]. همچنین رفتار نوسانی تحریک خطی دمپرهای ام. آر بر روی چهار مدل مختلف نیز مورد مطالعه قرار گرفته است[۳]. لی و همکارانش^۳ به رفتار ویسکوالاستیک در مدل دمپر ام. آر پرداختهاند [۴]. همچنین یک سیستم جایگاه تعلیق با مدل کنترلی شوک هوک[†] با دمپر های ام.آر توسط چيو ^ معرفي شده است[۵].

با توجه به گسترش این نسل جدید دمپرها در سال های اخیر و لزوم طراحی دقیق تر برای افزایش کارایی آنها، دستیابی به طراحی بهینه از اهمیت بسزایی برخوردار گردیده است. از طرفی تاکنون در کارهای انجام شده به بهینهسازی این نوع دمپرها پرداخته نشده است. از آنجایی که از این دمپرها در صنایع مختلف مثل صنایع

¹Wang et al ²Dvke et al

³LI et al

⁴shockhood

⁵Chio

هوافضا و در ماهوارهبرها استفاده می شود طراحی بهینه آن می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینهها، عمر و بازده آنها داشته باشد.

این مطالعه در حقیقت خلا ایجاد شده مربوط به طراحی دمپر مگنتولوژیک را پر میکند. ابتدا دمپر مذکور شبیه سازی شده و بخشی از نتایج حاصله با نتایج تجربی مقایسه میشود. سپس پارامترهای موثر بر عملکرد این دمپرها شناسایی شده و میزان اثرگذاری هر کدام از آنها بر عملکرد سیستم مطالعه شده است. همچنین توسط سیستم معکوسی که طراحی شده دمپر بهینه بدست آمده است. این سیستم معکوسی که طراحی شده دمپر بهینه در اثر آمده است. این سیستم معکوس ترکیبی از مدل نیوروفازی (Neuro-Fuzzy)و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) می باشد. در اثر این بهینه سازی دمپری طراحی شده که انرژی کمی مصرف میکند به عبارتی با حداقل انرژی الکتریکی بالاترین عملکرد را دارد و واکنش دمپر نیز بسیار سریع میباشد.

۱-۱ طراحی مفہومی دمپر

شکل(۱) ساختار اصلی یک دمپر سیلندر پیستون مگنتولوژیک را نشان میدهد که در آن قرقره سیم پیچی شده با خط وط عمودی هاشور خورده و پیستون دمپر که از جنس فولاد میباشد به عنوان یک هسته مغناطیسی برای این سیم پیچ میباشد تا بتوان شار مغناطیسی ایجاد کند. جریان شار مغناطیسی به حول محور هسته فولادی به قطر DC دوران دارد، قطب مغناطیسی پیستون به طول Lp، ضخامت مجرایی که سیال از میان آن عبور میکند g و ضخامت دیواره سیلندر tw میباشد.

دمپر مورد نظر برای طراحی دارای شش پارامتر هندسی فیزیکی میباشد، که شامل قطر محفظـه مـورد نظر کـه یـک لولـه توخـالی تراشیده شده می باشد D_b ، قطر میله پیستون D_r ، ضـخامت دیـواره سیلندر t_W ، قطـر هسـته D_c ،طـول قطـب L_p و ضـخامت شـکاف

عبوری سیال tgمیباشد.



تىنش برشى كىل سىال مگنتولوژيك از دو قسمت تشكيل مى گردد، تنش برشى تسليم ناشى از اعمال شار مغناطيسى و تاثير آن بر روى سيال و تنش برشى ناشى از ويسكوزيته[7]. افت فشار عبورى از پيستون Δp وابسته به ويسكوزيته و تنش تسليم سيال دارد[8]. از ساختار سيال نيو تنى مىتوان Δp_N را از رابط (٣) تقريب زد.

$$\Delta p_N = \frac{12Q\eta(2N_s)L_p}{\pi(D_p + t_g)t_g^3} \tag{(7)}$$

معداد قرقرههای سیم پیچی شده، Q دبی حجمی سیال N_s است. نیروی تولیدی در دمپر F، ناشی از افت فشار عبور پیستون از سطح مقطع سیلندر در هر زمان از رابطه زیر بدست میآید:

$$F = \Delta p \pi \frac{((D_p + t_g)^2 - D_r^2)}{4}$$
(f)

در نتیجه نیرو ناشی از سرعت پیستون، هندسه سیستم، خواص سیال مگنتولوژیک و چگالی شار مغناطیسی عبوری از مجرای بین سیلندر و پیستون بدست میآید.

۱-۴ رابطه غیر خطی مغناطیس ساکن

حجم کوچک سیال ام-آر بین دیواره سیلندر، قط ب مغناطیسی پیستون ، پیستون و سیلندر تحت تاثیر شار مغناطیسی قرار میگیرد. طبق قانون کیروشف برای میدان مغناطیسی خواهیم داشت:

$$\sum H_k L_k = Ni \tag{6}$$

 L_k میدان مغناطیسی حاصل از k تعداد ماده بوده و H_k طول موثر آنها که در میدان مغناطیسی میباشند است. تعداد دور سیم مغناطیسی پیچیده شده را با N و جریان عبوری از سیم را با i بیان می گردد. در قانون میدان مغناطیسی، شار مغناطیسی B با القای مغناطیسی افزایش مییابد($H = \mu \mu_0 H$) می نفوذ پذیری مغناطیسی² در خلا بوده و برابر(A / M = T = 0) میباشد. μ نسبت نفوذ پذیری بوده که از خواص ماده میباشد. در آستانه میدان() H_c بیشتر مواد مغناطیسی اشباع میشوند.

مغناطیسی را به خوبی بیان میکند استفاده مینماییم[۷]

$$H(B) = \frac{H_{c}B}{J_{b}} + \frac{1}{2s} * (\frac{1}{\mu_{0}} - \frac{H_{c}}{J_{b}})(e^{\arcsin h(s(B-J_{b}))} - e^{\arcsin h(J_{b})})$$
(Y)

که در رابطه بالا S دقت منحنی B-H میباشد . چگالی شار مغناطیسی برای هسته B_c برای دیواره B_w بوده و با توجه به بقای شار مغناطیسی عبوری ϕ_B خواهیم داشت:

 $\Phi_B = B_{\varrho} A_{\varrho}$

$$B_{C} = \frac{\Phi_{B}}{A_{C}}, \quad B_{W} = \frac{\Phi_{B}}{A_{W}} \tag{9}$$

(λ)

در روابط بالا A_g ، A_g ، A_c به ترتیب مساحت سطح مقطع هسته ، مجرای عبوری سیال و دیواره سیلندر می باشد. با تعیین میزان g می توان با کمک روابط (۸) و(۹) میزان چگالی شار و شار مغناطیسی را بدست آورد. همچنین با داشتن پارامترهای مغناطیسی (8و (H_c, J_b) برای فولادو سیال ام-آر سیستم، القای مغناطیسی هر قسمت را با کمک رابطه (7) محاسبه نمود. با بدست آوردن g R و H برای هر عضو مغناطیسی و کمک از رابطه(۱۰) می توان جریان الکتریکی مورد نظر را محاسبه نمود.

⁶ Magnetic permeability

$$i = \frac{1}{N} (2H_g t_g + H_c (l_c + l_p) + H_p (D_p + t_w) + H_w (l_c + l_p))$$
(1.)

تعداد دور سیم پیچ برای هر قرقره، l_c ، l_p به ترتیب طول هسته و قطب بوده و القای مغناطیسی را در مجرای عبوری سیال، قطب و هسته به ترتیب H_p ، H_g و H_c نشان داده می شود.

L خودالقایی (اندوکتانس) ،R مقاومت الکتریکی همچنـین T ثابت زمانی القایی (به عبارتی زمان واکنش سیال) میباشـد کـه از روابط زیر بدست میآیند.

$$L = \frac{N_s N \phi_B}{i} \tag{11}$$

$$R = rN \pi D_c N_s \tag{11}$$

$$T = \frac{L}{P} \tag{11}$$

در رابطه (۱۲) r مقاومت هر واحد طول سیم مغناطیسی انتخاب شده بوده همچنین برای بالا بردن عملکرد دمپر و میدان مغناطیسی قوی تر میتوان از چند قرقره سیم پیچی شده NS و یا سیم پیچی در چند لایه انجام شود(1 م).

۲–۲ بهینه ســازی دمپــر ام.آر بــا اســتفاده از سیســتم معکوس

برای بهینه سازی دمپر مورد مطالعه، تعداد دور سیم پیچ(turn)، (spool)، فاصله مجرای عبوری سیال (t_g) و طول قطب پیستون (L_p) به عنوان پارامتر ورودی و پارامتر (K=F/(T.J)) به ابه عنوان پارامتر (L_p) عنوان پارامتر خروجی درنظر گرفته شده است. پارامتر K بیان کننده نیروی تولیدی بهینه(F)، میزان مصرف انرژی حداقل(J)، سرعت واكنش بالاتر(T) مى باشد. سيستم معكوس تركيبي از مدل نيوروفازى و الگوريتم ازدحام ذرات مى باشد. ابتدا يک دمپر سيلندر پیستون با سیال مگنتولوژیک شبیه سازی شده و عملکرد آن به وسيله مدل نيوروفازي پيش بيني و سپس با الگوريتم ازدحام ذرات بهینه سازی شده است. در این مدل سازی مقدار ضخامت مجرا، طول قطب پیستون، تعداد دور سیم پیچ و تعداد قرقرههای سیم پیچی به عنوان ورودی و نسبت نیرو به زمان واکنش و انرژی الکتریکی مصرفی به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. کل دادههای مورد استفاده ۷۵۳۳ عدد بوده که از حل جریان متفاوت بدست آمده است. دادهها برای معرفی به نیوروفازی به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: حالت آموزش و تست. مدل نیوروفازی به وسیله دادههای آموزشی یاد می گیرد و بعد از آموزش، به وسیله دادههای تست توانایی این مدل در پیش گویی دقیق از دادهها مورد آزمایش قرار می گیرد. در مجموع برای محاسبه خطای این مدل از خطای مجموع مربعات(MSE)، خطای بی بعد مجموع مربعات(NMSE)، خطای مجموع قدر مطلق(MAE) و ضریب مشخصـه(R²) اسـتفاده شده است(معادلات (۱۴) تـا (۱۷)). در کـل مناسبترین تخمین نیوروفازی در حالتی بدست میآید که مقدار ضریب مشخصه به عدد ۱، خطای مجموع مربعات و خطای بی بعد مجموع مربعات و خطایی

۱۹-۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ISME2013

مجموع قدر مطلق به عدد صفر نزدیک تر باشند و هر چه این نزدیکی بیشتر باشد، مناسب تر بودن مدل را نشان میدهند.

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^{N} (O_i - T_i)}{N}$$
(14)

$$NMSE = \frac{1}{\sigma^2} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (O_i - T_i)^2$$

$$N(O_i - T_i)$$
(10)

$$MAE = \sum_{i=1}^{N} \frac{(O_i - V_i)}{N}$$
(19)
$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(O_i - V_i)^2}{N}$$

$$R^{2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N} \frac{N_{i}}{N}}{\sum_{i=1}^{N} \frac{(O_{i} - T_{m})^{2}}{N}}$$
(1V)

به طوری که O_i اولین مقدار عددی، T_i اولین مقدار تخمین زده شده، N تعداد دادهها و σ^2 واریانس دادههای عددی می باشد. در جدول (۱) خطاهای حاصله برای تجزیه و تحلیل عملکرد نیوروفازی نشان داده شده است. مقدار کم خطاها و همچنین مقدار بسیار نزدیک R^2 به ۱ ضریب مشخصه نشان دهنده صحت و دقت عالی مدل نیوروفازی می باشد.

مدول (۱) عملکرد نیوروفازی برای مقادیر اموزش و تست.	•
--	---

	MSE	NMSE	MAE	\mathbf{R}^2	
Train	0.000138	0.0023	0.007	0.997	
Test	0.0001383	0.0024	0.0071	0.998	

شکل (۲) نسبت K بر حسب تعداد دور سیم پیچ و طول قطب پیستون را نشان میدهد. در این شکل میتوان دید که افزایش تعداد دور سیم پیچ باعث افزایش نسبت K میشود. این رفتار به خوبی توسط مدل نیوروفازی تخمین زده شده است، زیرا این پیش بینی تایید کننده رفتار فیزیکی نیز میباشد.



شکل (۲) بهترین پیشگویی مدل نیوروفازی بر اساس K بر حسب تعداد دور سیم ییچ(Turn) و طول قطب پیستون(Lp)



کل (۵) بهترین پیستویی مدل ۲۱ ۲۹۲۹ بر اساس نسبت ۲۸ بر حسب عداد دور سیم پیچ (turn) و تعداد قرقرههای سیم پیچی شده(Spool) در تحقیق حاضر، هدف از بهینه سازی دست یابی به ماکزیمم مقدار نسبت ۲ میباشد. بهینه سازی برای یافتن بهترین مقدار ضخامت مجرا، طول قطب ، تعداد دور سیم پیچ و تعداد قرقرههای سیم پیچی شده مناسب برای رسیدن به ماکزیمم مقدار ۲ انجام شده است. تابع هدف ۲ برای همه دمپرها با روش نیوروفازی بر

نتیجه بهینه سازی در جدول (2) نشان داده شده این مقادیر بهترین حالت برای بیشترین مقدار K میباشد.لازم به ذکر میباشد که مقدار تعداد قرقرههای سیم پیچ باید عددی صحیح باشد بنابر این مقدار بدست آمده برای آن را به عدد مناسب تقریب زده می شود. حدول (2) مشخصات دمی بهینه شده

اساس نتایج عددی بدست آمده از حل عددی بدست آمده است.

······································						
	turn	spool	gap	LP	K	
	745.63	2.12	0.705	1.044	4.597	

الگوریتم ازدحام ذرات K=4.597 را برای این دمپر تقریب زده است. برای اعتبار سنجی نتایج الگوریتم فوق با شبیه سازی عددی برای تعداد دور سیم پیچ 746، تعداد قرقرههای سیم پیچی شده 2، طول قطب پیستون 1.044mm و ضخامت مجرای عبوری سیال بین سیلندر و پیستون 0.75mm مقدار K محاسبه میشود. نسبت نیروی دمپر به انرژی الکتریکی مصرفی و زمان واکنش K=4.86 بدست میآید، در صورتی که با روش ازدحام ذرات مقدار 18) معادل ۵/۷% بدست آمده است. میزان خطای آن طبق رابطه (18) معادل ۵/۷%

$$Error = \left| \frac{K(CFD) - K(PSO)}{K(CFD)} \right| = 0.057 \quad (18)$$

در پایان میتوان با توجه به مقادیر دمپر بهینه شده مقدار نیروی دمپر را بر حسب سرعت و جابجایی در جریانه ای مختلف بدست آورد.(شکل(4) و (5))

۳- نتیجه گیری و جمع بندی

با طراحی تئوری یک دمپر سیلندر پیستون و شناسایی پارامتر های موثر بر آن سعی بر بهینه سازی آن گردیده. هدف اصلی بهینه سازی یافتن بهترین مقدار ضخامت مجرا، طول قطب ، تعداد دور سیم پیچ و تعداد قرقرههای سیم پیچی شده مناسب برای رسیدن به ماکزیمم مقدار k بوده است. مقادیر بهینه در جدول (۲) مشاهده می شود و برای اطمینان از این بهینه سازی

۱۹-۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ISME2013

این مقادیر را در مدل شبیه سازی قرار داده شده است خطایی ایجـاد شده برابر ۵/۷% میباشد که قابل قبـول میباشـد. ایـن دمپـر در بـازه گستردهای از نیروی میرایی در جریان های مختلف الکتریکی می توانـد عمل کند. شکل (۴)و(۵).





۴- مرجع

[¹] Wang K W, Kim Y S and Shea D B 1994 "Structural vibration control via electrorheological-fluid-based actuators with adaptive viscous and frictional damping" J. Sound Vib. 177 227–37

[2] Dyke S J, Spencer B F Jr, Sain M K and Carlson J D 1998 "An experimental study of MR dampers for seismic protection Smart Mater".Struct. 7 693–703

[3] Wereley N M, Pang L and Kamath G M 1998" Idealized Hysteresismodeling of electrorheological and magnetorheological dampers" J. Intell.Mater. Syst. Struct. 9642–9

[4] Li W H, Yao G Z, Chen G, Yeo S H and Yap F F 2000 "Testing and steady state modeling of a linear MR damper under sinusoidal loading Smart Mater". Struct. 995–102

[5] Choi S B, Nam M H and Lee B K 2000 "Vibration control of a MR seat damper for commercial vehicles" J. Intell. Mater.Syst. Struct. 11 936–44

[6] Henri GAVIN, Jesse HOAGG and Mark DOBOSSY (2001)." OPTIMAL DESIGN OF MR DAMPERS". Proc. U.S.-Japan Workshop on Smart Structures for Improved Seismic Performance in Urban Regions,14 August 2001, Seattle WA, ed. K. Kawashima, B.F. Spencer, and Y. Suzuki, pp 225-236.

[7] Gavin, H.P. (1998). "Design method for high-force electrorheological dampers." Smart Materials and Structures, Vol. 7, No. 5, 664-673.